



Title of Change:	Qualification of ON Niigata, Japan as additional wafer source for ON Semiconductor switching diode and transistor.	
Proposed first ship date:	23 February 2019	
Contact information:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Hiroshi.Koizumi@onsemi.com>	
Samples:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <PCN.samples@onsemi.com> Sample requests are to be submitted no later than 30 days from the date of first notification, Initial PCN or Final PCN, for this change.	
Additional Reliability Data:	Contact your local ON Semiconductor Sales Office or <Dustin.Tenney@onsemi.com>	
Type of notification:	This is a Final Product/Process Change Notification (FPCN) sent to customers. FPCNs are issued 90 days prior to implementation of the change. ON Semiconductor will consider this change accepted, unless an inquiry is made in writing within 30 days of delivery of this notice. To do so, contact <PCN.Support@onsemi.com>	
Change Part Identification:	Affected products will be identified with date code.	
Change Category:	☒ Wafer Fab Change ☐ Assembly Change ☐ Test Change ☐ Other _____	
Change Sub-Category(s):	☒ Manufacturing Site Addition ☐ Material Change ☐ Datasheet/Product Doc change ☐ Manufacturing Site Transfer ☐ Product specific change ☐ Shipping/Packaging/Marking ☐ Manufacturing Process Change ☐ Other: _____	
Sites Affected:	ON Semiconductor Sites: ON ISMF, Malaysia ON Niigata, Japan	External Foundry/Subcon Sites: None
Description and Purpose: ON Semiconductor is notifying customers of the qualification of ON Niigata, Japan as additional wafer source for ON Semiconductor switching diode and transistor. The affected products listed in this notification are currently sourced from ON Semiconductor ISMF fabrication facility in Seremban, Malaysia. Niigata Fab facility is an ON Semiconductor owned wafer fab that has been producing products for ON Semiconductor. Several existing technologies within ON Semiconductor's product families are currently sourced from Niigata Fab. ON Semiconductor Niigata Wafer Fab is an internal factory that is TS16949, ISO-9001 and ISO-14000 certified. Qualification tests are designed to show that the reliability of the transferred devices will continue to meet or exceed ON Semiconductor standards		
	Before Change Description	After Change Description
Wafer fab	ON Semiconductor ISMF FAB, Malaysia	ON Semiconductor ISMF FAB, Malaysia ON Semiconductor Niigata, Japan
There is no product marking change as a result of this change.		

**Reliability Data Summary:****QV DEVICE NAME** NSVBAS21SLT1G**RMS:** L46827**PACKAGE:** SOT23

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	2016 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	30000 cyc	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	-	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	-	0/30

QV DEVICE NAME BAS21LT1G**RMS:** L46828**PACKAGE:** SOT23

Test	Specification	Condition	Interval	Results
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1008 hrs	0/77

Electrical Characteristic Summary:

Electrical characteristics are not impacted by this change. Characterization data is available upon request.

**List of Affected Parts:**

Part	Qualification Vehicle
BAL99LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAS16LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAS16LT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAS19LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAS19LT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAS20LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAS20LT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAS21LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAS21LT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAS21SLT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAV23CLT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAV23CLT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAV70LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAV70LT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAV74LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAW56LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAW56LT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD2835LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD2836LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD2837LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD2838LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD6050LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD6050LT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD6100LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD7000LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD7000LT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD914LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD914LT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G

Japanese translation of the notification starts here.
通知の日本語訳はここから始まります。

Note: *The Japanese version is for reference only. In case of any differences between the English and Japanese version, the English version shall control.*

注：日本語版は参照用です。英語版と日本語版の違いがある場合は、英語版が優先されます。



最終製品 / プロセス変更通知

文書番号: FPCN22406X

発行日: 2018 年 11 月 16 日

変更件名:	オン・セミコンダクターのスイッチングダイオードおよびトランジスタのウェハー製造追加拠点としてオン新潟(日本)を認定							
初回出荷予定日:	2019 年 2 月 23 日							
連絡先情報:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Hiroshi.Koizumi@onsemi.com> お問い合わせください。							
サンプル:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <PCN.samples@onsemi.com> お問い合わせください。 サンプルは、この変更の初回通知、初回 PCN、または最終 PCN の日付から 30 日以内に要求してください。							
その他の信頼性データ:	現地のオン・セミコンダクター営業所または <Dustin.Tenney@onsemi.com> お問い合わせください。							
通知種別:	これは、お客様宛の最終製品 / プロセス変更通知 (FPCN) です。FPCN は、変更実施の 90 日前に発行されます。 オン・セミコンダクターは、この通知の送付から 30 日以内に書面による問い合わせがない限り、この変更が承諾されたものとみなします。お問い合わせは、<PCN.Support@onsemi.com> お願いします。							
変更部品の識別:	影響を受ける製品は日付コードで識別します。							
変更カテゴリ:	☒ ウェハファブの変更 ☐ アセンブリの変更 ☐ 試験の変更 ☐ その他 _____							
変更サブカテゴリ:	☒ 製造拠点の追加 ☐ 材料の変更 ☐ データシート/製品資料の変更 ☐ 製造拠点の移転 ☐ 製品仕様の変更 ☐ 出荷/パッケージング/表記 ☐ 製造プロセスの変更 ☐ その他: _____							
影響を受ける拠点:	オン・セミコンダクター拠点: オン ISMF (マレーシア) オン新潟 (日本)	外部ファウンドリまたは下請け業者拠点: なし						
説明および目的: オン・セミコンダクターは、スイッチングダイオードおよびトランジスタのウェハー製造追加拠点としてオン新潟(日本)を認定することをお客様に通知いたします。本通知により影響を受ける一覧製品は、現在セレンバン(マレーシア)のオン・セミコンダクター ISMF で製造されています。 オン新潟 Fab は、当社製品の製造を行っている自社ウェハー製造施設です。オン・セミコンダクター製品ファミリーでの既存技術のいくつかは新潟 Fab で製造されています。オン・セミコンダクター新潟 Fab は自社工場で、TS16949、ISO-9001、および ISO-14000 の認定を受けています。品質試験は移管されたデバイスの信頼性が引き続きオン・セミコンダクターの基準以上となっていることを検証できるように設計されています。 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>変更前の表記</th> <th>変更後の表記</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ウェハ製造施設</td> <td>オン・セミコンダクター ISMF FAB (マレーシア)</td> <td>オン・セミコンダクター ISMF FAB (マレーシア) オン・セミコンダクター新潟 (日本)</td> </tr> </tbody> </table> 今回の変更に伴う製品表示の変更はありません。				変更前の表記	変更後の表記	ウェハ製造施設	オン・セミコンダクター ISMF FAB (マレーシア)	オン・セミコンダクター ISMF FAB (マレーシア) オン・セミコンダクター新潟 (日本)
	変更前の表記	変更後の表記						
ウェハ製造施設	オン・セミコンダクター ISMF FAB (マレーシア)	オン・セミコンダクター ISMF FAB (マレーシア) オン・セミコンダクター新潟 (日本)						



信頼性データの要約:

QV 素子名 NSVBAS21SLT1G

RMS: L46827

パッケージ: SOT23

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	2016 hrs	0/231
HTSL	JESD22-A103	Ta= 150°C	1008 hrs	0/231
IOL	MIL-STD-750 (M1037) AEC-Q101	Ta=+25°C, delta Tj=100°C On/off = 2 min	30000 cyc	0/231
TC	JESD22-A104	Ta= -55°C to +150°C	1000 cyc	0/231
HAST	JESD22-A110	130°C, 85% RH, 18.8psig, bias	192 hrs	0/231
uHAST	JESD22-A118	130°C, 85% RH, 18.8psig, unbiased	96 hrs	0/231
PC	J-STD-020 JESD-A113	MSL 1 @ 260 °C	-	
RSH	JESD22- B106	Ta = 265C, 10 sec	-	0/30

QV 素子名 BAS21LT1G

RMS: L46828

パッケージ: SOT23

テスト	仕様	条件	間隔	結果
HTRB	JESD22-A108	Ta=150°C, 100% max rated V	1008 hrs	0/77

電気的特性の要約:

電気的特性はこの変更の影響を受けません。要求に応じて特性データが入手可能です。



影響を受ける部品の一覧:

製品 ID	品質試験用ピークル
BAL99LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAS16LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAS16LT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAS19LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAS19LT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAS20LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAS20LT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAS21LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAS21LT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAS21SLT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAV23CLT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAV23CLT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAV70LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAV70LT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAV74LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAW56LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
BAW56LT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD2835LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD2836LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD2837LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD2838LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD6050LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD6050LT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD6100LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD7000LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD7000LT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD914LT1G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G
MMBD914LT3G	NSVBAS21SLT1G, BAS21LT1G